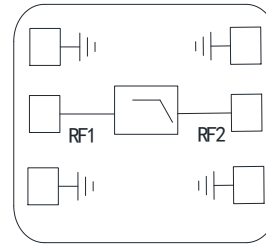


特点:

- 通带频率: DC~1.0GHz
- 通带损耗: $\leq 1.1\text{dB}$
- 阻带衰减: $21\text{dB}@1.65\text{GHz}$
 $40\text{dB}@1.9\text{GHz}$
- 回波损耗: 27dB
- 芯片尺寸: $1.3\text{mm}\times 1.3\text{mm}\times 0.16\text{mm}$

功能框图:



产品简介:

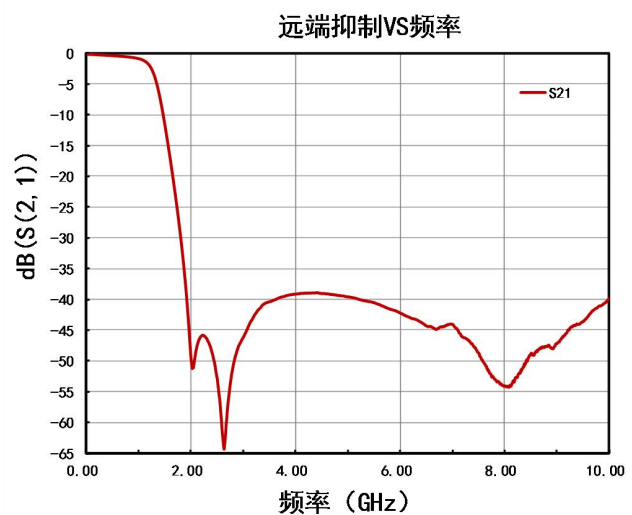
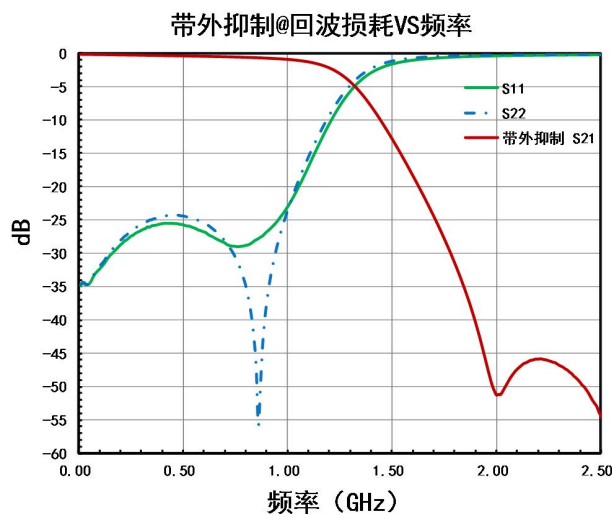
YDC8625 是一款采用 GaAs 工艺设计制造的低通滤波器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

性能参数: (50Ω系统, $T_A=+25^\circ\text{C}$)

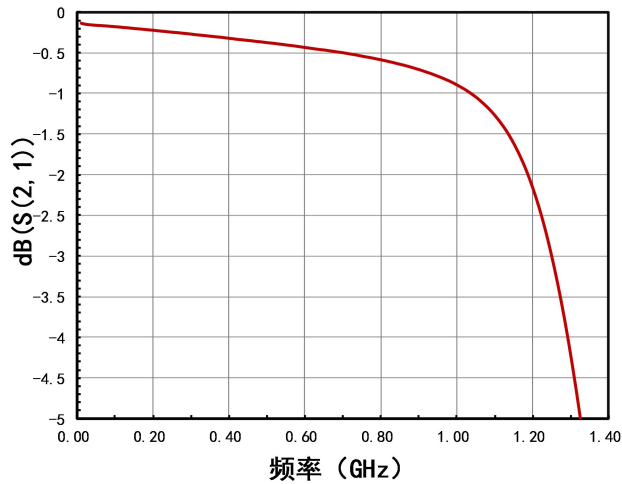
参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	DC	-	1.0	GHz
插入损耗	IL	-	-	1.1	dB
阻带衰减@1.65GHz	-	-	21	-	dB
阻带衰减@1.9GHz	-	-	40	-	dB
端口回波损耗	RL	-	27	-	dB

*: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

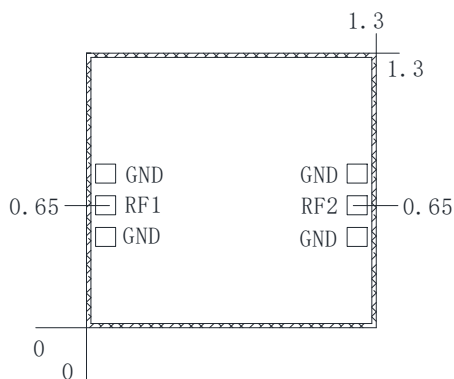
典型测试曲线: (50Ω系统, $T_A=+25^\circ\text{C}$)



通带插损VS频率



外形尺寸图:



引脚定义:

符号	描述
RF1	射频端口
RF2	射频端口
GND/芯片背面	接地，芯片底部需接地良好

极限参数表:

参数名称	极限值
最大输入	+30dBm
装配温度	+300°C, 20s
工作温度	-55°C~+85°C
贮存温度	-55°C~+150°C
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数，可能造成器件永久损坏。



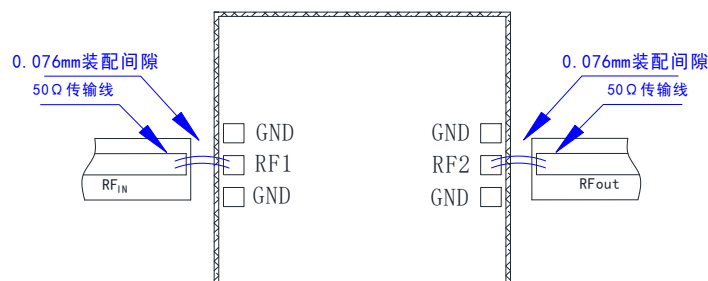
注: 1.单位: mm;

2.芯片背面镀金，背面接地;

3.外形尺寸公差: $\pm 0.05\text{mm}$;

4.键合压点镀金，压点尺寸: $0.1 \times 0.1\text{mm}$ 。

推荐装配图:



注: 射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸，典型的装配间隙是 0.076~0.152mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm 。

产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面，使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时，需考虑热膨胀应力对芯片的影响，芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上，如可伐、钨铜或钼铜垫片上，避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过+300°C，时间不能超过 20 秒），使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 25um 双金丝键合，建议金丝长度 0.25~0.40mm（10~16 mils）。
6. 在存储和使用过程中注意防静电，烧结、键合台接地良好。